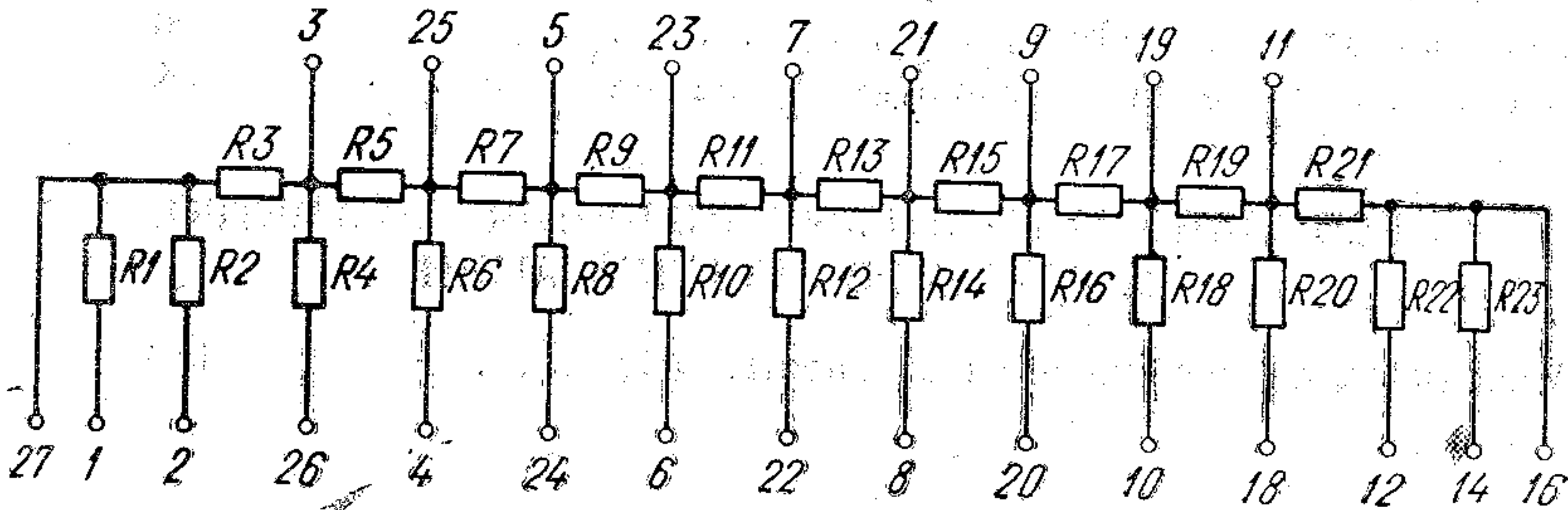


ДЕКОДИРУЮЩАЯ РЕЗИСТИВНАЯ МАТРИЦА
ТИПА R-2R

301НР4А—
301НР4М

Пози- цион- ное обо- зна- чение	Расчетный номинал, Ом, для типов микросхем												
	301НР4А	301НР4Б	301НР4В	301НР4Г	301НР4Д	301НР4Е	301НР4Ж	301НР4И	301НР4К	301НР4Л	301НР4М		
R1	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	
R2	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	2R	
R3	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
R4	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	R	
R5	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
R6	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	R	
R7	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
R8	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	R	
R9	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
R10	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	R	
R11	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
R12	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	R	
R13	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
R14	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	R	
R15	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
R16	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	R	
R17	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
R18	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	R	
R19	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
R20	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	R	
R21	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
R22	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	R	
R23	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	R	

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25°C)

Входное напряжение на выводах 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26 относительно вывода 1, В, не более . . .	12,6
Сопротивление изоляции (испытательное напряжение 100 В прикладывается между экраном и закороченными выводами), МОм	100
Сопротивление резисторов, кОм:	
2R	от 9,212 до 10,788
R	от 4,606 до 5,394
Относительная погрешность коэффициентов деления, %	±0,01
Время установления переходных процессов, мкс, не более	0,5

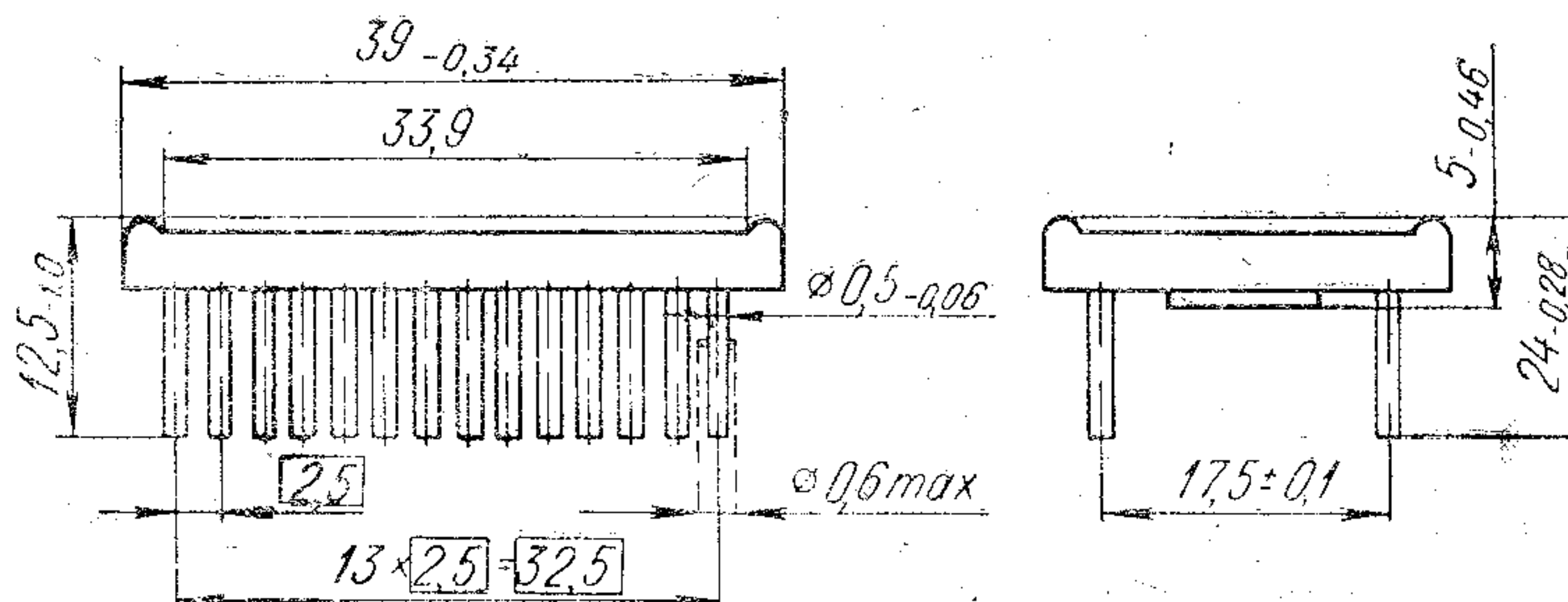
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальная рассеиваемая мощность, мВт	150
---	-----

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 301

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса не более 10 г

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц

для микросхем 301НР1—301НР6	от 1 до 3000
» » 301НР7—301НР12	от 1 до 5000

амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)

для микросхем 301НР1—301НР6	150 (15)
» » 301НР7—301НР12	400 (40)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)

для микросхем 301НР1—301НР6	5000 (500)
» » 301НР7—301НР12	15 000 (1500)

длительность действия ударного ускорения, мс

от 0,1 до 2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)

для микросхем 301НР1—301НР6	750 (75)
» » 301НР7—301НР12	1500 (150)

длительность действия ударного ускорения, мс

от 1 до 5

Линейное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)

1500 (150)

Повышенная температура среды, °С:

для микросхем 301НР1—301НР6	85
» » 301НР7—301НР12	100

Пониженная температура среды, °С

минус 60

Изменения температуры среды, °С:

для микросхем 301НР1—301НР6	от минус 60 до +85
» » 301НР7—301НР12	от минус 60 до +100

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 301

Общие данные

Атмосферное пониженное давление, мм рт. ст. (Па):	
для микросхем 301НР1—301НР6	5 (665)
» » 301НР7—301НР12	10 ⁻⁶
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка ^О , ч	25 000
Срок сохраняемости ^О , лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Допускается кратковременная двухкратная перегрузка по напряжению на входах с сохранением характеристик во время и после снятия перегрузки. Длительность воздействия перегрузки для микросхем 301НР1—301НР6 — 2 мин, для микросхем 301НР7—301НР12 — 5 мин, количество перегрузок — не более 5 в течение 1 ч, интервал между перегрузками — не менее 8—10 мин.

Выводы микросхем формовке не подлежат. В технически обоснованных случаях допускается удалять нерабочие выводы микросхем и излишки рабочих выводов после пайки любым способом, исключая нарушение запрессовки вывода в основании корпуса и не приводящим к ухудшению электрических параметров микросхем.

^О В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.